
	<h2 style="color: red;">FDP047N10</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDP047N10</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 120A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FDP047N10.pdf 2.FDP047N10.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 50191 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDP047N10
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 120A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	50191 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	8 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 120A (Tc) 375W (Tc) Through Hole
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	375W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.7 mOhm @ 75A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	210nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	15265pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FDP047N10 ist neu im Original, Suche FDP047N10 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP047N10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP047N10: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDP047N08-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 164A TO220-3</p>	 <p>FDP047AN08AO F FDP047AN08AO F</p>	 <p>FDP050 FSC FDP050 FSC</p>	 <p>FDP047N08 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 164A TO-220</p>
 <p>FDP047N08 FDK America MOSFET N-CH 75V 164A TO-220</p>	 <p>FDP050AN06AO Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 80A TO-220AB</p>	 <p>FDP047N08AO FSC FDP047N08AO FSC</p>	 <p>FDP050AN06AO AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 80A TO-220AB</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FDP027N08B	↔ FDP030N06	⇒ FDP030N06	D FDP030N06B_F102	↗ FDP032N08
⊣ FDP032N08	⊗ FDP032N08B	D FDP036N10A	⇒ FDP036N10A	↗ FDP038AN06AO
⊗ FDP038AN06AO	⊣ FDP038AN06AO	⊗ FDP039N08B	↔ FDP040N06	↗ FDP040N06
D FDP045N10A	⊗ FDP045N10A	⊣ FDP047AN08	⊗ FDP047AN08AO	↗ FDP047AN08AO
⇒ FDP047AN08AO	↔ FDP047N08	⊗ FDP047N08	⊣ FDP047N08AO	↗ FDP047N10
↔ FDP050AN06AO	⇒ FDP050AN06AO	D FDP050AN06AO	⊗ FDP053N08B	⊣ FDP053N08B_F102
⊗ FDP054N10	D FDP054N10	⇒ FDP060AN08AO	↔ FDP060AN08AO	↗ FDP060AN08AO
⊣ FDP060N08AO	⊗ FDP060N08AO	↔ FDP068AN08AO	⇒ FDP070AN06AO	↗ FDP070AN06AO
⊗ FDP070AN06AO	⊣ FDP075N15A	⊗ FDP075N15A	D FDP083N15A	↗ FDP083N15A
↔ FDP083N15A_F102	⊗ FDP085N10A	⊣ FDP085N10A	⊗ FDP085N10A_F102	↗ FDP090N10

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited